








	<h2>SI1926DL-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1926DL-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 60V 0.37A SOT363</p> <p>Datenblätter:  SI1926DL-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 44069 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1926DL-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 0.37A SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	44069 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 370mA 510mW
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	510mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	370mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 340mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	18.5pF @ 30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1926DL-T1-GE3-ND


















SI1926DL-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1926DL-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1926DL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1926DL-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI1958DH-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT363	 SI1926DL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 0.37A SC-70-6	 SI1926DL-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 0.37A SOT363	 SI1922EDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 1.3A SOT-363
 SI1926A Vishay Precision Group SI1926A VISHAY	 SI1958DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 1.3A SC70-6	 SI1965DH-E3 VISHAY SI1965DH-E3 VISHAY	 SI1958DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 1.3A SC70-6

heiße Teile

Mehr

 SI1905DL-T1	 SI1905DL-T1-E3	 SI1905DL-T1-E3	 SI1905DL-T1-GE3	 SI1906DL-T1
 SI1912EDH	 SI1912EDH-T1	 SI1912EDH-T1-E3	 SI1912EDH-T1-E3	 SI1912EDH-T1-GE3
 SI1913DH-T1-E3	 SI1913DH-T1-E3	 SI1913DH-T1-GE3	 SI1913EDH-T1	 SI1913EDH-T1-E3
 SI1913EDH-T1-E3	 SI1913EDH-T1-GE3	 SI1917EDH-T1	 SI1917EDH-T1-E3	 SI1917EDH-T1-E3
 SI1917EDH-T1-GE3	 SI1922EDH-T1-GE3	 SI1922EDH-T1-GE3	 SI1926DL-T1-E3	 SI1926DL-T1-E3
 SI1926DL-T1-GE3	 SI1958DH-T1-E3	 SI1958DH-T1-E3	 SI1965DH-E3	 SI1965DH-T1-E3
 SI1965DH-T1-E3	 SI1965DH-T1-GE3	 SI1965DH-T1-GE3	 SI1967DH-T1-E3	 SI1967DH-T1-E3
 SI1967DH-T1-GE3	 SI1967DH-T1-GE3	 SI1969DH-E3	 SI1970DH-T1-GE3	 SI1970DH-T1-GE3
 SI1972DH-T1	 SI1972DH-T1-E3	 SI1972DH-T1-E3	 SI1972DH-T1-GE	 SI1972DH-T1-GE3
 SI1972DH-T1-GE3	 SI1973DH-E3	 SI1983DT-285-T1-E3	 SI1988DH-T1-GE3	 SI1988DH-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited